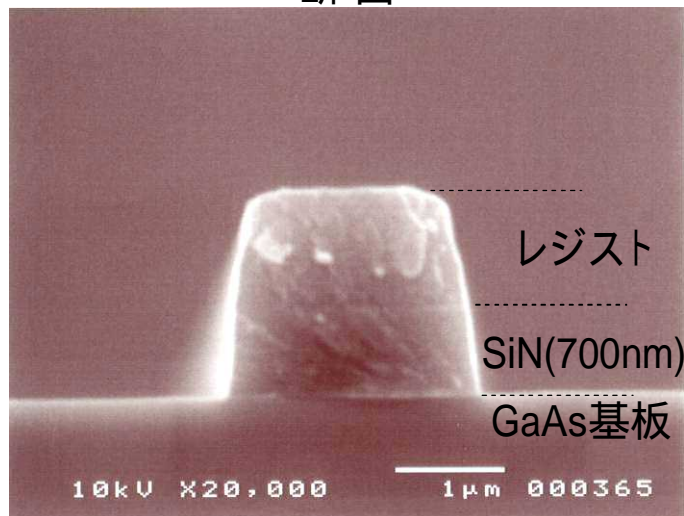
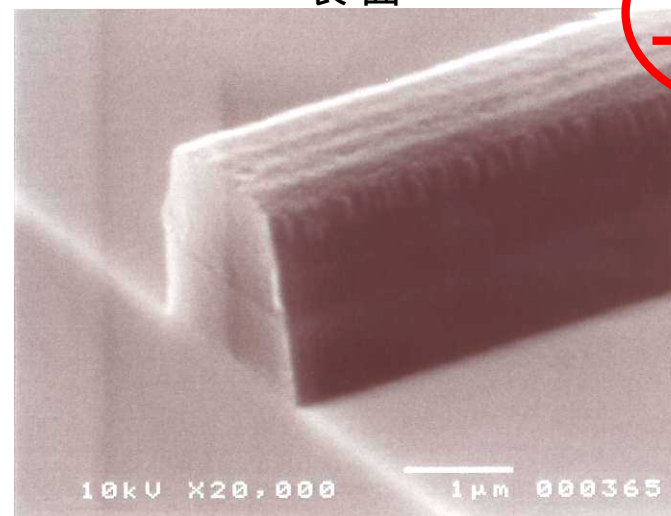


CHF₃を用いたSiN加工

< 断面 >



< 表面 >



< 処理条件 >

RF Power (W)	CHF ₃ /O ₂ (sccm)	Press. (Pa)	E.Rate (nm/min.)	Sel. (SiN/PR)	Unif. (± %)
175	10/1	2.0	89.6	2.2	1.8

サンプルサイズ: φ3inch Unif.のみφ6inch^ハタSiNで測定

< 備考 >

装置: RIE-10NR
石英トレイ使用
電極間隔: 55mm
水冷チラー(25)

- ・ CHF₃を用いたSiNの異方性エッチングが可能。レジスト形状がテーパであっても、SiNをある程度垂直にエッチングできる。また、SiNの膜質によってエッチング速度が変わる事も判っている。
- ・ SiNエッチングする際、CHF₃単体では若干デポぎみに働く模様で、O₂を微量添加する事によりエッチングレートも上がる事が確認されている。